

InGaAs фотодиод 1654 нм, 200 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIMT-01A

ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность
Низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Детектирование в ближнем ИК-диапазоне
Мониторинг
Измерительные приборы

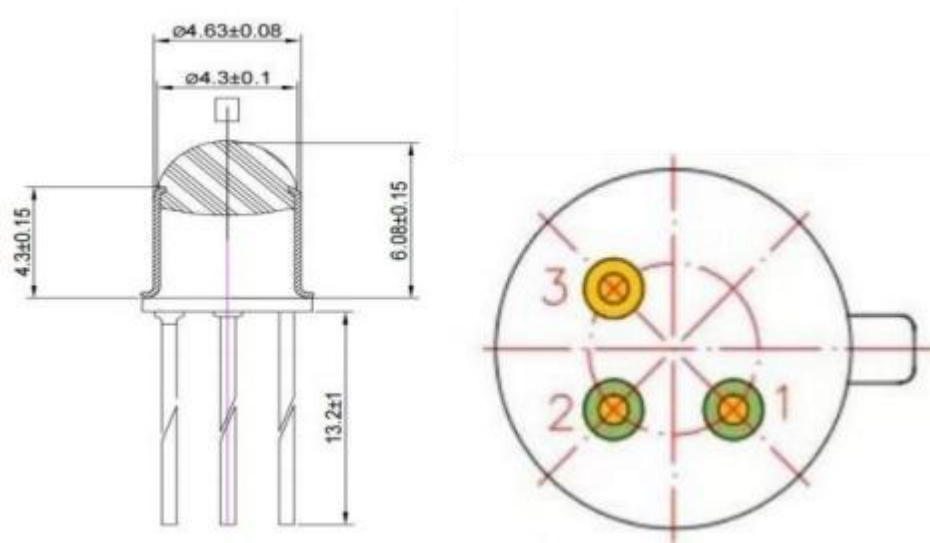
Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	VR=-1V	-	-	1	нА
Напряжение обратного смещения	Vbr	Ir=-1μA	30	40	-	В
Емкость	C	VR=-3V,1MHz	-	3	5	пФ
Чувствительность	R	@1654nm,VR=0V	0.9	0.95	-	А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	Top	-10	60	°C
Температура хранения	Tstg	-40	125	°C
Прямой ток	If	-	10	мА

Назначение выводов и габаритный чертёж



Тип соединения выводов (пинов)	
Вывод	Номер
1	PD+
2	PD-
3	GND